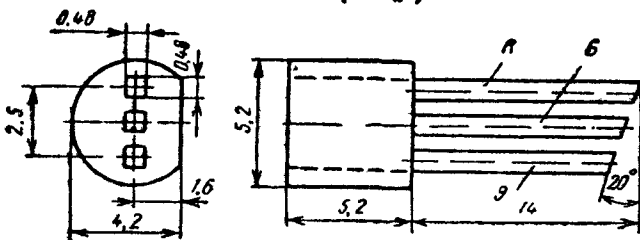


КТ502 (А, Б, В, Г, Д, Е)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных дифференциальных и импульсных усилителях, преобразователях. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

КТ502 (А-Е)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кв}=5$ В, $I_D=10$ мА:

| | |
|--------------------------------|----------|
| КТ502А, КТ502В, КТ502Д, КТ502Е | 40...120 |
| КТ502Б, КТ502Г | 80...240 |

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кв}=5$ В, $I_D=3$ мА, не менее

Граничное напряжение при $I_D=10$ мА, $t_u \leq 30$ мкс, $Q \geq 100$, не менее:

| | |
|----------------|------|
| КТ502А, КТ502Б | 25 В |
| КТ502В, КТ502Г | 40 В |
| КТ502Д | 60 В |
| КТ502Е | 80 В |

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, не более

| | |
|-------------------|---------|
| типичное значение | 0,6 В |
| | 0,15* В |

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, не более

| |
|--------|
| 1,2 В |
| 0,8* В |

типичное значение

Обратный ток коллектора при $U_{кв}=U_{кв, макс}$, не более

1 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{кв}=5$ В, $f = 465$ кГц, не более

20 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

| | |
|----------------|------|
| КТ502А, КТ502Б | 40 В |
| КТ502В, КТ502Г | 60 В |
| КТ502Д | 80 В |
| КТ502Е | 90 В |

Постоянное напряжение база — эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора

0,15 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мс, $Q \geq 100$

0,35 А

Постоянный ток базы

0,1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

0,35 Вт

Температура *p-n* перехода

+125 °С

Температура окружающей среды

-40 +85 °С

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5 2 мм; при этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.